

明石工業高等専門学校	開講年度	令和03年度(2021年度)	授業科目	固体物性A
科目基礎情報				
科目番号	0022	科目区分	専門 / 必修	
授業形態	講義	単位の種別と単位数	学修単位: 2	
開設学科	電気情報工学科(電気電子工学コース)	対象学年	4	
開設期	前期	週時間数	2	
教科書/教材	萩野俊郎「エッセンシャル応用物性論」朝倉書店			
担当教員	大向 雅人			
到達目標				
1) シュレーディンガー方程式を理解し、これを利用して原子内の電子状態を定量的に理解する。 2) 原子の化学結合について理解し、固体のバンド理論についてに知る。 3) ホール効果について定量的に説明できる。 4) p-n接合の電流電圧特性を定量的に理解する 5) 空乏層容量を導出できる				
ルーブリック				
評価項目[1]	理想的な到達レベルの目安  シュレーディンガー方程式を深く理解し、これを利用して原子内の電子状態を定量的に十分理解する。	標準的な到達レベルの目安  シュレーディンガー方程式を理解し、これを利用して原子内の電子状態を定量的に理解する。	未到達レベルの目安  シュレーディンガー方程式を理解し、これを利用して原子内の電子状態を定量的に理解しない。	
評価項目[2]	原子の化学結合について深く理解し、固体のバンド理論についてに詳細に知る。	原子の化学結合について理解し、固体のバンド理論についてに知る。	原子の化学結合について理解し、固体のバンド理論についてに知らない。	
評価項目[3]	ホール効果について定量的に詳しく説明できる。	ホール効果について定量的に説明できる。	ホール効果について定量的に説明できない。	
評価項目[4]	p-n接合の電流電圧特性を定量的に深く理解する	p-n接合の電流電圧特性を定量的に理解する。	p-n接合の電流電圧特性を定量的に理解しない。	
評価項目[5]	空乏層容量を詳細に導出できる。	空乏層容量を導出できる。	空乏層容量を導出できない。	
学科の到達目標項目との関係				
学習・教育到達度目標 (D) 学習・教育到達度目標 (H)				
教育方法等				
概要	電子デバイスの中で固体の役割は極めて大きい。本講義では電子の基礎となる前期量子論から固体中の電子状態について学び、金属および半導体内での電子の挙動を基本的な観点から定量的に学ぶ。			
授業の進め方・方法	最初に講義を行い概略を説明したあと、各自が自主学習を行う。質問等の個人指導を行い、不明な点を解消する。課題レポートにより、理解を深めたり、学習範囲を広げていく。			
注意点	授業中は集中して理解に努め、わからないところを授業中に質問して解決していくプロセスが求められる。毎回復習が必要。本科目は授業で保証する学習時間と、予習、復習および課題レポート作成に必要な標準的な自己学習時間の総計が90時間に相当する学習内容である。課題提出が締切を越えると未提出扱いとなる。合格の対象としない欠席条件(割合) 1/3以上の欠課			
授業の属性・履修上の区分				
<input checked="" type="checkbox"/> アクティブラーニング	<input type="checkbox"/> ICT 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 遠隔授業対応	<input type="checkbox"/> 実務経験のある教員による授業	
授業計画				
	週	授業内容	週ごとの到達目標	
前期	1stQ	1週	量子論、シュレーディンガー方程式	
		2週	ボアの理論と原子軌道	
		3週	共有結合とエネルギー・バンド	
		4週	電気伝導、位相速度と群速度	
		5週	分散関係と有効質量とブリルアンゾーン	
		6週	自由電子論、状態密度	
		7週	ホール効果と移動度	
		8週	中間試験	
後期	2ndQ	9週	半導体内のキャリヤ統計 I	
		10週	半導体内のキャリヤ統計 II	
		11週	半導体と金属の接触	
		12週	AINシュタインの関係式	
		13週	P-N接合のI-V特性	
		14週	空乏層の容量	

		15週	復習	これまでの内容を復習し頭を整理する。余裕があればドリフトトランジスタについて知る。
		16週	期末試験	60点以上を取得する。

### モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標

分類	分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル	授業週	
専門的能力	分野別の専門工学	電気・電子系分野	電子工学	電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。	4	前1,前5
				エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。	4	前3
				原子の構造を説明できる。	4	前2
				パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。	4	前2
				結晶、エネルギー帯の形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギー帯図を説明できる。	4	前3
				金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。	4	前4,前6,前7
				真性半導体と不純物半導体を説明できる。	4	前5,前9,前10
				半導体のエネルギー帯図を説明できる。	4	前3,前5,前11
				pn接合の構造を理解し、エネルギー帯図を用いてpn接合の電流-電圧特性を説明できる。	4	前13
				バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギー帯図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。	4	前15
				電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。	4	前15

### 評価割合

	試験	課題	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合計
総合評価割合	70	0	0	0	0	30	100
基礎的能力	0	0	0	0	0	0	0
専門的能力	70	0	0	0	0	30	100
分野横断的能力	0	0	0	0	0	0	0